



No. 2017-014

優秀修士論文賞

電気電子工学専攻

中村 悠太 殿

論文題目: ゲートドライブ回路モデルを考慮した
SiC-MOSFET過渡特性のシミュレーション検討

東京工業大学大学院理工学研究科
電気電子工学専攻の修士課程において優
れた研究と論文発表を行いましたのでこれ
を賞します

平成29年3月26日

東京工業大学

電気電子工学専攻長 廣川二郎